

ПРОГРАММА СТЕНДОВОЙ КОНКУРСНОЙ СЕССИИ

- С-01 А.Д. Малевская**
Верификация трубковой модели растекания тока и анализ карт электролюминесценции фотопреобразователей при помощи анализа трёхмерной распределённой эквивалентной схемы
- С-02 А.К. Романчук**
Омические контакты к субэлементам многопереходного GaInP/GaInAs/Ge фотопреобразователя
- С-03 О.Е. Лакунцова**
Гетероструктуры с КТ InAs/InGaAs и сверхтонкими метаморфными буферными слоями $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}(001)$
- С-04 М.Р. Шарнас**
Влияние собственных и примесных дефектов на электронные и фононные свойства GeTe
- С-05 М.А. Миролубов**
Резонансный туннельный эффект в акустическом волноводе
- С-06 Е.В. Доморацкий**
Связанные состояния в континууме в полупроводниковой гетероструктуре InAs/In_xGa_{1-x}As
- С-07 А.А. Зотов**
Эффект аномальной температурной зависимости дислокационной люминесценции в ионно-имплантированном кремнии
- С-08 М.И. Кузьменко**
Обменное взаимодействие дырок с ионами марганца в двойной полумагнитной квантовой яме
- С-09 Ю.А. Тиманкова**
Исследование направленного рассеяния на димере из лабиринтных акустических метаатомов
- С-10 И.В. Коклюшкина**
Синтез и исследование люминесценции ортофосфатов иттрия и лютеция, активированных Eu^{3+}
- С-11 Н.А. Миронов**
Электромагнитный отклик мультирезонансных метаматериалов на основе диоксида ванадия
- С-12 А.А. Караваева**
Смесовые диэлектрические пленки MgF_2+ZnS для светоизлучающих диодов
- С-13 С.Н. Хруль**
Электрические свойства гетероструктур GaPN(As)/Si
- С-14 В.И. Гусев**
Сопротивление p-n-перехода на основе квантовых точек
- С-15 Д.М. Ласкин**
Смена знака циркулярной поляризации люминесценции в режиме оптической ориентации дырочных трионов и магнитополяронный эффект в квантовых ямах CdMnTe
- С-16 А.Р. Колесникова**
Метаповерхности Гюйгенса на основе материала с фазовой памятью
- С-17 В.А. Поздеев**
Исследование качества пассивации кремния в структурах $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Si}/\text{Al}_2\text{O}_3$, полученных методом PE-ALD
- С-18 Б.Ю. Ключев**
Исследование механических напряжений в гетероструктурах GaN/AlGaN на подложках SiC во время эпитаксии
- С-19 И. Шмидт**
Электрические свойства транзисторов на основе оксида индия олова (ITO), полученных методом импульсного лазерного осаждения (PLD)
- С-20 В.А. Калинин**
Исследование модуля Юнга и изменения ширины запрещённой зоны в перовскитах CsPbX_3 под воздействием давления
- С-21 П.Д. Корниенко**
Применимость DDD-метода для оценки радиационной стойкости метаморфных фотоэлектрических преобразователей излучения
- С-22 М.В. Левичев**
Оптимизация сильной связи в гибридной поляритонной системе Ag/WS₂/HNK GaP
- С-23 Т.Э. Зедоми**
Фото- и термоиндуцированные сдвиги в оптических свойствах нанокмозитов с частицами As₂S₃ и Au
- С-24 Qinghao Song**
Optical properties of mixed halide perovskites for modern solar cells
- С-25 В.Н. Малец**
Сравнение характеристик полупроводниковых лазеров со ступенчатым р-волноводом
- С-26 А.Д. Родиончикова**
Исследование ван-дер-ваальсовых гетероструктур на основе графена, MoTe₂ и WSe₂ методами сканирующей зондовой микроскопии
- С-27 И.И. Янибеков**
Моделирование образования дефектов, их реакций, и расчет уровня Ферми в гексагональном нитриде бора
- С-28 В.В. Гришунов**
Механизм экзотермической реакции пористого кремния в контакте с окислителем
- С-29 П.А. Сырников**
Исследование катодоллюминесцентных свойств кристаллов YAG:Nd, полученных методом флюса с использованием хлорида натрия